汕头华汕电子器件有限公司

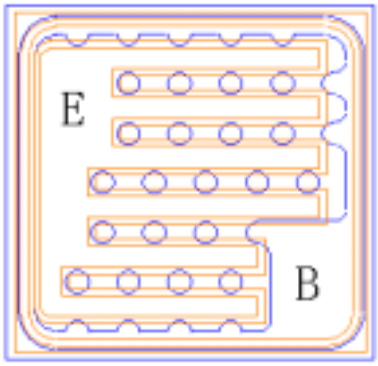
NPN SILICON TRANSISTOR

D880 晶体管芯片说明书

■ 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C150AG-01
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：1500×1500μm^2
焊位尺寸：B 极 290×450μm^2；E 极 285×450μm^2
电极金属：铝
背面金属：银
典型封装：2SD880，HD880

■ 管芯示意图



■ 极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-220）

T_{stg}——贮存温度…… -55~150℃
T_j——结温……150℃
P_C——集电极耗散功率……30W
V_{CBO}——集电极—基极电压…… 60V
V_{CEO}——集电极—发射极电压…… 60V
V_{EBO}——发射极—基极电压……7V
I_C——集电极电流…… 3A
I_B——基极电流…… 0.3A

■ 电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-220）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	μA	V_{CB}=60V，I_E=0
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	μA	V_{EB}=7V，I_C=0
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	60				I_C=50mA，I_B=0
h_{FE}	直流电流增益	60		300		V_{CE}=5V，I_C=0.5A
	直流电流增益	20				V_{CE}=5V，I_C=3A
V_{CE}(sat)	集电极—发射极饱和电压		0.4	1	V	I_C=3A，I_B=0.3A
V_{BE}(on)	基极—发射极导通电压		0.7	1	V	V_{CE}=5V，I_C=0.5A
f_T	特征频率		3		MHz	V_{CE}=5V，I_C=0.5A
C_{ob}	共基极输出电容		70		pF	V_{CB}=10V，I_E=0，f=1.0 MHz
t_{ON}	导通时间		0.8		μs	V_{CE}=30V，I_C=2A I_{B1}=-I_{B2}=0.2A
t_{STG}	载流子贮存时间		1.5		μs	
t_F	下降时间		0.8		μs	